

平成15年12月24日

委員各位

独立行政法人 日本学術振興会
「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員長 梅野 正隆

独立行政法人日本学術振興会
「結晶加工と評価技術」第145委員会 第99回研究会

テーマ：「ワイドギャップ系半導体の結晶工学とデバイス」

日時：2004年2月24日（火）午後1時から5時30分

場所：弘済会館「きくの間」

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1, TEL: 03(5276)0333

JR四ツ谷駅下車徒歩5分

地下鉄丸ノ内線四ツ谷駅下車徒歩5分、または地下鉄有楽町線麹町駅下車徒歩2分

世話人： 田島 道夫（JAXA 宇宙科学研究本部）、 奥村 次徳（都立大学 工学研究科）

プログラム：

- (1) 大口径単結晶 3C-SiC ウエハー製造技術 13:05 ~ 13:45
長澤 弘幸, 河原 孝光, 八木 邦明
(HOYA アドバンスト セミコンダクタ テクノロジーズ(株))
- (2) 非c面上への4H-SiCエピ成長とデバイス応用 13:45 ~ 14:25
木本 恒暢(京都大学 大学院工学研究科)
- (3) SiC MOS界面制御技術とMOSFET特性の向上 14:25 ~ 15:05
福田 憲司, 先崎 純寿, 小杉 亮治, 原田 信介, 岡本 光央, 加藤 真, 鈴木 賢二 (産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター)
- 休憩 15:05 ~ 15:15
- (4) RF-MBE成長したInNの構造・特性とバンドギャップエネルギー 15:15 ~ 15:55
名西 穂之¹⁾, 齋藤 義樹¹⁾, 山口 智広¹⁾, 松田 文絵¹⁾, 荒木 努¹⁾,
直井 弘之²⁾, 鈴木 彰³⁾, 播磨 弘⁴⁾, 宮嶋 孝夫⁵⁾
1) 立命館大学 工学部, 2) 立命館大学 COE 推進機構, 3) 立命館大学
総合理工学研究機構, 4) 京都工芸繊維大学 工学部, 5) ソニー(株) CNC CT 開発本部
- (5) フラックスを用いたGaNバルク結晶のLPE成長 15:55 ~ 16:35
森 勇介, 川村 史朗, 吉村 政志, 佐々木 孝友(大阪大学 大学院工学研究科)
- (6) SiC基板の表面制御とAlNヘテロエピタキシャル成長への効果 16:35 ~ 17:15
須田 淳(京都大学 大学院工学研究科)
- (7) 委員総会 17:15 から